

Atlas DCA

анализатор на полупроводникови компоненти

Модел: DCA55

Проектиран и произведен във Великобритания

PEAK

electronic design ltd

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Характеристики

- Свързване в произволен ред
- Автоматична идентификация на типът на компонента.
- Авт. идентификация на изводите.
- Измерване на коеф. на усилване на биполярни транзистори.
- MOSFET измерване прага на гейта.
- Измерване х-ките на PN-преходи.
- Измерване на тока на утечка.
- Автоматично и ръчно изключване.
- Ултра-компактен дизайн.

Поддържани компоненти

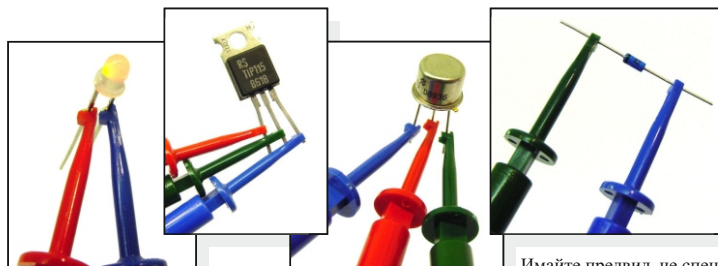
- Транзистори (Германиеви и Силициеви).
- Дарлингтон тр-ри.
- MOSFET тр-ри.
- JFET Полеви тр-ри (идент-я на гейта) .
- Нискомощни тиристоры и симисторы.
- LED (вкл. двуцветни).
- Диоди и Диодни мрежи.



Удобен
Интелигентен
Точен

Примерен дисплей за типичен транзистор:

NPN Silicon Transistor +	Тук, Atlas DCA е детектирал NPN транзистор.
RED GREEN BLUE Base Emit Coll +	Определено е разположението на изводите.
Current gain $h_{FE}=117$ +	Постояннотоковото усилване е измерено при кол. ток 2.5mA.
Test current $I_C=2.50mA$ +	
Base-Emitter V $V_{BE}=0.71V$ +	Измерен е спада на напрежение върху База-Емитер.
Test current $I_B=4.58mA$ +	
Leakage current $I_C=0.00mA$ +	Накрая, измерен е и тока на утечка.



Имайте предвид, че спецификациите на нашите продукти подлежат на промяна без предупреждение. E&OE. 02/13

Техническа спецификация

Parameter	Minimum	Typical	Maximum	Notes
Peak test current into S/C	-5.5mA		5.5mA	1
Peak test voltage across O/C	-5.1V		5.1V	1
Measurable transistor gain range (h_{FE})	4		20000	2
Transistor gain accuracy ($h_{FE}<1000$)	-3%-5 hFE		+3%+5 hFE	2,9
Transistor V_{CEO}	2.0V		3.0V	2
Transistor V_{BE} accuracy	-2%-20mV		+2%+20mV	9
V_{BE} for Darlington identification		1.0V		3
V_{BE} for Darlington identification (shunted)		0.8V		4
Acceptable transistor V_{BE}			1.80V	
Base-emitter shunt resistance threshold		60k Ω		
Transistor collector-emitter test current	2.45mA	2.50mA	2.55mA	
Acceptable transistor collector leakage		1.25mA		6
MOSFET gate threshold range	0.1V		5.0V	5
MOSFET gate threshold accuracy	-2%-20mV		+2%+20mV	5
MOSFET drain-source test current	2.45mA	2.50mA	2.55mA	
MOSFET minimum gate resistance		8k Ω		
Thyristor/Triac gate test current		4.5mA		7
Thyristor/Triac load test current		5.0mA		
Diode test current			5.0mA	
Diode forward voltage accuracy	-2%-20mV		+2%+20mV	
V_f for LED identification		1.50V		
Battery type	GP23A 12V Alkaline			
Battery voltage range	7.50V	12V		
Battery voltage warning threshold		8.25V		
Inactivity power-down period		30 secs		
Dimensions (excluding test leads)	103 x 70 x 20 mm			
Operating temperature range	0°C	°C	50	8

1. Между произволна двойка тест сонди
2. Колекторен ток 2.50mA.
3. Съпр. върху обратно поляризиран база-емитер >60k Ω .
4. Съпр. върху обратно поляризиран база-емитер <60k Ω
5. Ток дрейн-сорс 2.50mA.
6. Напр. Колектор-Емитер 5.0V.
7. Тиристор квадрант I, симистор квадранти I и III
8. В зав-ст от приемлива видимост на LCD дисплея
9. БИП без шунтови резисторы.

Ретроникс Инженеринг - Официален дистрибутор за България

Web: www.peak-bg.com Email: sales@peak-bg.com